		Поз. обозначе- ние			Нс	Ko	Л.	Примеч	ание		
H H	<u>د</u>		K	онденса	торы	К53-68 АЖЯР.673546.007ТУ					
Перв. примен	9M6.673.175		k	Сонденса	торы	К10-846 ФЦТА.673516.016ТУ					
lep 6.		C1	K53-68"E"-50B-10,0 мкФ±10%								
		C2	K10-846 57	'50M-50E	3-H90-	-2,2 мкФ-N-А	1				
		С3	K10-846 20	112M-50B	-H20-	4700 nΦ±10%-N-A	1				
		C4	K53-68"E"-50B-10,0 мкФ±10%								
		C5	K10-846 20	112M-50B	-H20-	4700 nΦ±10%-N-A	1				
		C6, C7	K10-846 20	112M-50B	-M47-	-33 nФ±10%-N-A	2				
2		C8-C10	K10-846 32	16M-25B	-H20-	3					
Cnpaß.		C11	K10-846 32	16M-25B	-H20-	1					
		C12	K10-846 32	16M-25B	-H20-	.0,15 мкФ±10%-N-A	1				
		C13-C15	K53-68"D"-	25B-1,0	мкФ±1	3					
		C16-C20	K10-846 32	16M-25B	-H20-	0,15 мкФ±10%-N-A	5				
		C21, C22	K53-68"C"-	25B-10,0	мкФ±	:10%	2				
		C23, C24	К10-846 5750М-50В-Н90-2,2 мкФ-N-А								
		C25	K10-846 3216M-25B-H20-0,15 мкФ±10%-N-A								
		C26	K10-846 32	-H20-	1						
дата		C27, C28	K53-68"C"-	25B-10,0	мкФ±	:10%	2				
Подп.		C29	K10-846 32	16M-25B	-H20-	0,15 мкФ±10%-N-A	1				
		C30	K53-68"D"-	25B-10,0	мкФ±	10%	1				
δл.		C31, C32	K10-846 32	216M-25B	-H20-	.0,15 мкФ±10%-N-A	2				
N° ∂yδ∧.		C33	K53-68"D"-	25B-15,0	мкФ±	10%	1				
Инв		C34	K53-68"D"-	25B-10,0	мкФ±	10%	1				
ŝ		C35	K10-846 32	16M-25B	-H20-	0,15 мкФ±10%-N-A	1				
		C36, C37	K53-68"C"-	25B-10,0	мкФ±	:10%	2				
Взам. инв.		C38-C41	K10-846 32	3-H20-	4						
								•			
Зата											
Подп. и дата											
Под						9M6.673	.175	175ПЭЗ			
-		Изм. Лист Разраб. 3	№ докум. арифуллин	Подп	Дата			/lum.	Лист	Листов	
подл.			узанов			Плата управления по тангах	ку 📘	, idili.	1	5	
NH6. №		Н. контр. Х	аликова			Перечень элементов		9M			
₹			Jaūхуллин			,					

Поз. обозначе ние	- Наименование	Кол.	Примечание		
C42	К10-848 5750M-50B-H90-2,2 мкФ-N-A	1			
C43-C50	K10-848 3216M-25B-H20-0,15 мкФ±10%-N-A	8			
	Модули электропитания БКЯЮ.436630.001ТУ	++			
DA1	МДМ5-1Е09МП	1			
DA2	МДМ3-2E1515МП	1			
	Микросхемы 140УДЗ1АТ1 BK АЕЯР.431130.171–17ТУ				
	Микросхемы 1335ЕН5П АЕЯР.431420.809ТУ	+++			
	Микросхемы 5321EH04Г4 АЕНВ.431420.461-02ТУ	+++			
	Микросхемы 5321EH03Г5 АЕНВ.432420.461-02ТУ	+++			
	Микросхемы 5321EM06Б5 AEHB.431420.461-03ТУ	+			
DA3, DA		2			
DA5	1335ЕН5П	1			
DA6	5321EH04Γ4	1			
DA7	5321EH03Г5	1			
DA8	5321EM06Б5	1			
DA9	140УД31АТ1 ВК	1			
	Микросхемы				
DD1	5559NH14AY AEAP.431230.652TY	1			
DD2	1986ВЕ92У1 АЕЯР.431290.711ТУ	1			
L1	Дроссель ДФПК7,5-2/0,4 БКЮС.670109.002-01ТУ	1			
	Резисторы Р1 ОЖО.467.164ТУ				
	Резисторы СП3-19α2-0,5 ОЖ0.468.134ТУ	$\perp \perp \perp$			
R1-R8	P1-8B-0,25-10 k0m±5%-T-A-M	8			
R9	P1-8B-0,25-24 кОм±5%-T-A-M	1			
R10	P1-8B-0,25-10 K0M±5%-T-A-M	1			
R11, R12		2			
R13, R14	P1-8B-0,25-300 Om±5%-T-A-M	2	Лисп		
	9M6.673.1	9М6.673.175ПЭЗ			
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата		2		

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозначе- ние	Наименов	ание Н	Кол.	Примечание		
R15, R16	Р1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М	2				
R17	СПЗ-19a2-0,5-1 кОм±10%		1			
R18	Р1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R19	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R20	Р1-8МП-0,25-1,78 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R21	Р1-8МП-0,25-9,09 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R22, R23	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		2			
R24	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R25	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R26	P1-8B-0,25-5,1 0м±5%-T-A-M		1			
R27-R30	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		4			
R31	Р1-8МП-0,25-20 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R32	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R33	СПЗ-19a2-0,5-47 кОм±10%		1			
R34	Р1-8МП-0,25-30,1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R35	P1-8MП-0,25-20 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R36-R38	Р1-8МП-0,25-10 кОм±1%-Ж-К-М		3			
R39	Р1-8МП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R40	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R41	Р1-8МП-0,25-301 кОм±1%-Ж-К-М	1				
R42	P1-8B-0,25-1 к0м±5%-T-A-M		1			
R43	Р1-8МП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R44	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
R45*	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М		1	51,1 кОм; 100 кОм,		
				допускается не		
				устанавливать		
R46	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М	1				
R47	P1-8MП-0,25-100 кОм±1%-Ж-К-М	1				
R48	P1-8B-0,25-510 Om±5%-T-A-M	1				
R49*, R50*	Р1-8МП-0,25-51,1 кОм±1%-Ж-К-М	2	30,1 k0m; 51,1 k0m; 100 k0m			
R51	Р1-8МП-0,25-5,11 кОм±1%-Ж-К-М	1				
R52	Р1-8МП-0,25-1 кОм±1%-Ж-К-М		1			
		0M4 472 17ED22				
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	9M6.673.175	ללו	3		

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
R53	Р1-8MП-0,25-6,19 кОм±1%-Ж-К-М	1	
R54, R55	Р1-8МП-0,25-1 к0м±1%-Ж-К-М	2	
VD1-VD3	Нαδορ диодов 2Д707АС9 αΑΟ.339.583ТУ	3	
VD4	Стабилитрон Д818Е СМ3.362.025ТУ СМ3.362.083ГЧ	1	
VD5, VD6	Нαδορ диодов 2Д707АС9 αΑ0.339.583ТУ	2	
	Транзисторы аАО.339.559ТУ		
VT1	2T665A9	1	
VT2	2T664A9	1	
	Вилка		
XP1, XP2	СНП346-10ВП22-2-В РЮМК.430420.011ТУ	2	
XP3	СНП401-6ВП21-4-1-2 РЮМК.430420.078ТУ	1	
XP4	СНП401-8ВП21-4-1-2 РЮМК.430420.078ТУ	1	
XP5	СНП401–16ВП21–4–1–2 РЮМК.430420.078ТУ	1	
XS1	Розетка СНП346-10РП21-2-В РЮМК.430420.011ТУ	1	
ZQ1	Descuerron DK/E7 E/IC 16M TU 6221 011 0760/009 07	1	
ZUI	Резонатор РК457-5ДС-16М ТУ 6321-011-07604008-07	+	
		++	
		++	
		++	
	·		Лисп

Подп. дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		Лист регистрации изменений								
		Номе	ра листов	(страниі			Nº	Входящий № сопрово-		
	Изм.	изменен- ных	ных ных	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	l ackingon	и дата и дата	Подп.	Да- та
ата										
Подп. дата										
۸.										
P dyδ										
Инв. № дубл.										
Н										
Взам. инв. №										
Заам.										
H										
дата										
р п										
Подп. и										
\square										
Инв. № подл.		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>
±6. №						9M6	5.673.175Γ	133		/lucm
Ż	Изм.	/lucm Nº∂	окум. По	Эп. Дата						5